4P048 N0<sup>+</sup>イオンの内部原子価状態とその解離ダイナミクス

(九大院・総理工<sup>1</sup>, 分子研<sup>2</sup>, KEK-PF<sup>3</sup>)

寺坂元寿<sup>1</sup>,三好永作<sup>1</sup>,彦坂泰正<sup>2</sup>,青戸智浩<sup>3</sup>,伊藤健二<sup>3</sup>

【はじめに】

過去数年にわたって本討論会においてわれわれは $O_2^+$ イオンおよび $N_2^+$ イオンの内部原 子価状態と解離ダイナミクスについての理論計算について報告してきた.イオン化状態のポ テンシャルエネルギーに対する振動解析を行い理論イオン化強度を計算した結果は,彦坂 らによる,それぞれのしきい光電子分光スペクトルの形をよく説明した[1-3].また,これらのイ オン化状態からの非断熱遷移確率を Zhu-Nakamura の式をもちいて計算し,解離ダイナミク スを議論した[2].今回, $NO^+$ イオンの解離過程についても実験を行い,得られたしきい光電 子分光スペクトル(図1)の形を説明するために,これまでと同様に  $NO^+$ イオンの内部原子価 状態についての電子状態計算を行った.さらに,理論による光電子分光スペクトルを計算し, 実測されたスペクトルの同定を行なうとともに解離過程のダイナミクスを論ずる.



【計算方法】

電子状態の計算には,NおよびO原子 ともスレーター型函数STF(6s4p)[4]に2個 の3d型STF(軌道指数N:3.100,2.192,O: 3.600,2.546)と1個の4f型STF(軌道指数 N: 3.030, O: 3.450)を加えて STF(6s4p2d1f)を使用した.1s 電子を除い た10電子8軌道を活性空間として状態平 均によるCASSCF計算を行い,分子軌道 を得た.得られた分子軌道により活性空間

からの 1,2 電子励起による MRSDCI 計算を行った. $C_{\infty v}$  対称性を利用し,プログラム ALCHEMY2 を使った.イオン化強度を計算するために,NO 基底状態の平衡核位置  $R_e$ の 近くで NO<sup>+</sup>イオンの電子状態は大きく変化しなければ,強度は

$$\left(E_f - E_i\right) \cdot \left| \left\langle \Phi_{\text{nucl}}^f(\boldsymbol{R}) \right| M_{\text{elec}}(\boldsymbol{R}) \left| \Phi_{\text{nucl}}^i(\boldsymbol{R}) \right\rangle \right|^2$$
(1)

$$tctcl, M_{elec}(R) = \left\langle \Phi^{f}_{elec}(\{\mathbf{r}\}, R) \mathbf{r} | \Phi^{i}_{elec}(\{\mathbf{r}\}, R) \right\rangle$$
(2)

に比例する.(2)式は電子部分であるが,これを一電子イオン化状態の重みで近似する.(2) 式を計算するためには核の運動(振動)に対する波動函数が必要であるがこれを求めるた めに,Discrete Variable Representation (DVR)法を用いた. 【計算結果および議論】

ALCHEMY2 によって得られた 20 状態の  $\Sigma^+$ 状態についての MRSDCI 計算によるポテン シャル曲線を図2に示す. 垂直な2本線で Frank-Condon 領域を表している.



表1.NO<sup>+</sup>イオンのスペクトル定数 method Re ()  $\omega e(cm^{-1})$  De/Te (eV) state  $X^1$ MRSDCI 1.07 2261 10.54 2376 exp 1.06 11.00  $a {}^{3}\Sigma^{+}$ MRS DCI 1.30 1284 6.25 1293 1.28 6.47 exp  $b^{3}\Pi$ 1.18 MRSDCI 1710 7.20 exp 1.18 1710 7.34 1594 8.99  $A^{1}\Pi$ MRSDCI 1.20 1.19 1602 9.11 exp

図2から明らかなように多くの偽交差が起こって おり,解離において非断熱遷移が重要な役割を 果たすことが予想される.電子状態計算の精度を 見るために各状態の核間距離・振動定数・項エネ ルギー・解離エネルギーを計算した.実測値と共 に表1に示す.表を見ると精度よく計算できたこと

が分かる.さらに,得られたポテンシャル曲線( ${}^{1}\Sigma^{+}, {}^{3}\Sigma^{+}, {}^{1}\Pi, {}^{3}\Pi$ )を使ってイオン化強度を計 算した.20~45 eV 領域への理論イオン化強度を図3に示す.図を見ると実験結果の主なピ



-クを再現できていることがわかる.さらに,
 電子状態を同定した.この領域では<sup>1</sup>Σ<sup>+</sup>,
 <sup>1</sup>Π, <sup>3</sup>Π状態が支配的であることが分かった.

現在,各解離極限での解離生成物の運動エネルギー分布を求めるために Zhu-Nakamura 理論を用いて非断熱遷移 確率を計算中である.その結果と解析は 当日発表する.

## 【参考文献】

- Y. Hikosaka, T. Aoto, R. I. Hall, K. Ito, R. Hirayama, N. Yamamoto, and E. Miyoshi, J. Chem. Phys. 119, 7693-7700 (2003).
- [2] R. Hirayama, N. Yamamoto, and E. Miyoshi, J. Chem. Phys. 120, 11330-11332 (2004).
- [3] T. Aoto, K. Ito, Y. Hikosaka, A. Shibasaki, R. Hirayama, N. Yamamoto, and E. Miyoshi, J. Chem. Phys., 124, 234306-1-6 (2006).
- [4] T. Koga, H. Tatewaki, and A. J. Thakkar, Phys. Rev. A47, 4510-4512 (1993).